

製品概要

NCP51530: 高性能、700 V- 3.5/3.0 A ハイ/ロー・ サイド MOSFET ドライバ

技術情報は、データシートをご参照ください。

NCP51530 は 700 V ハイ・ サイド / ロー・ サイド・ ドライバで、AC-DC 電源 / インバータ向け高ドライブ機能があります。NCP51530 は、高周波数動作で最高の伝播遅延、低静止電流、低スイッチング電流を実現します。よって、高周波数動作をする電源の高効率設計が可能です。NCP51530 は SOIC8 および DFN10 パッケージで提供します。

特長

- High voltage range: Up to 700 V
- Very fast propagation delay (25 ns for B version)
- Matched propagation delay (7 ns Max)
- High dv/dt immunity up to 50 V/ns and negative transient immunity
- DFN10 packaging with optimized pin-out
- Fast Rise and Fall times (15 ns max)

利点

- Design margin for AC/DC design
- Suitable for high frequency operation
- Increased efficiency & Allow paralleling
- Very robust design
- Small PCB footprint, improved creepage distance and parasitic
- Suitable for heavy loads

アプリケーション

- Half and Full-bridge Converters
- Active Clamp Flyback adapters
- Motor controls Power Supply

最終製品

- Power Supply for Servers, Telecom and Industrial
- Electric power steering
- Solar inverters

電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Power Switch	Number of Outputs	Topology	Isolation Type	V _{in} Max (V)	V _{CC} Max (V)	Rise Time (ns)	Fall Time (ns)	Drive Source Current Typ (A)	Drive Sink Current Typ (A)	Turn On Prop. Delay Typ (ns)	Turn Off Prop. Delay Typ (ns)	Delay Matching	Package Type
NCP51530ADR2G	0.864	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	MOS FET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	700	20	8	8	3.5	3	60	60	7	SOIC-8
NCP51530AMNTWG	0.833	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	MOS FET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	700	20	8	8	3.5	3	60	60	7	DFN-10
NCP51530BDR2G	0.864	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	MOS FET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	700	20	8	8	3.5	3	25	25	7	SOIC-8
NCP51530BMNTWG	0.6893	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	MOS FET / IGBT	2	High-Low	Junction Isolation	700	20	8	8	3.5	3	25	25	7	DFN-10

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

7/31/2021 作成